



# 宽带隙半导体技术国家重点学科实验室

首页 | 实验室概况 | 科研团队 | 科学研究 | 仪器设备 | 合作交流 | 最新消息 | 通知公告

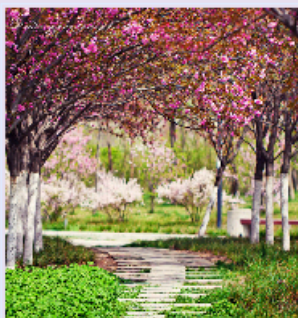
科学研究

科研奖项

授权专利

论文著作

研究成果



您现在的位置: 首页 >> 科学研究 >> 授权专利 >> 专利授权情况-2012年

## 专利授权情况-2012年

序号	专利名称	发明人	授权时间	专利号/申请号	专利类别
1	基于规则拓扑库面向应用的片上网络生成方法	蔡觉平	2012年 1月8日	ZL201010144088.6	发明
2	基于a面6H-SiC衬底上非极性a面GaN的MOCVD生长方法	郝跃 李志明	2012年 2月8日	201010209324.8	发明
3	电磁加热装置	郝跃 许晟瑞	2012年 2月8日	200810232210.8	发明
4	基于c面SiC衬底上极性c面GaN的MOCVD生长方法	郝跃 许晟瑞	20120208	201010209567.1	发明
5	基于r面Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 衬底上非极性a面GaN薄膜的MOCVD生长方法	郝跃 许晟瑞	2012年 3月28日	201010209566.7	发明
6	基于SiC衬底的AlGaIn基多量子阱uv-LED器件及制作方法	郝跃 杨凌	2012年 5月9日	200910021761.4	发明
7	基于m面SiC衬底的非极性m面GaN薄膜的MOCVD生长方法	郝跃 许晟瑞	2012年 5月23日	201010209325.2	发明
8	二维网状片上网络系统	蔡觉平 魏洁 李赞 姚磊 王韶力 郝跃	2012年 5月9日	201010507200.8	发明
9	高速数据交换接口的数据缓存器及其数据缓存控制方法	马佩军 刘宇	2012年 5月9日	200910023890.7	发明
10	基于c面Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 衬底上极性c面GaN薄膜的MOCVD生长方法	郝跃 许晟瑞	2012年 6月27日	201010209323.3	发明
11	高电子迁移率晶体管	张进成 付小凡	2012年 6月27日	201110001515.X	发明

